3415

12V P 沟道 MOS 场效应管

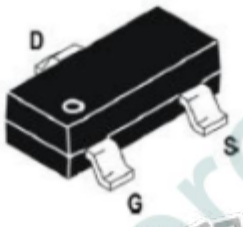
$R_{DS(ON)}$ <55mΩ @ V_{GS}=-4.5V
$R_{DS(ON)}$ <75mΩ @ V_{GS}=-2.5V

试用水印 试用水印 试用水印

产品特征

- 超低电阻
- 可靠耐用

封装信息



SOT23-3

试用水印 试用水印 试用水印

最大额定值 (T_A=25℃，除非另有说明)

符号	参数	值	单位
V_{DSS}	漏源电压	-12	V
V_{GSS}	栅源电压	±8	
I_D	漏极电流	-3.5	A
I_{DM}	漏极脉冲电流	-8	
T_J	最大结温	150	℃
T_{STG}	储存温度	-55 to 150	
$R_{\theta JA}$[b]	结环热阻	150	℃/W

试用水印 试用水印 试用水印

www.superchip.cn